

# 日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会

平成 24 年度 第 1 回委員会

日 時： 平成 24 年 9 月 29 日 (土), 11:30-16:40

会 場： 和歌山大学 システム工学部 B 棟 B101 室  
(和歌山県和歌山市栄谷 930 番地)

## プログラム

A00 11:30~11:40

開会の挨拶

日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会

委員長 藤田静雄 (京都大学大学院工学研究科)

A01 11:40~12:00

熱アニールによる希土類添加半導体 AlGaN の紫外発光特性向上

石津勇太 \*1, 市井邦之 \*1, 來山真也 \*1, 喜多隆 \*1, 千木慶隆 \*2, 西本哲朗 \*2, 田中寛之 \*2, 小林幹弘 \*2, 石原嗣生 \*3, 泉宏和 \*3

(\*1) 神戸大学大学院工学研究科, (\*2) 株式会社ユメックス, (\*3) 兵庫県立工業技術センター

A02 12:00~12:20

OMVPE 法による Eu 添加 GaN の選択成長と発光特性評価

長谷川亮介 \*1, 若松龍太 \*1, 小泉淳 \*1, 大淵博宣 \*2, 一宮正義 \*3, 李東建 \*1, 寺井慶和 \*1, 本間徹生 \*2, 芦田昌明 \*3, 藤原康文 \*1

(\*1) 大阪大学大学院工学研究科, (\*2) JASRI/SPring-8, (\*3) 大阪大学大学院基礎工学研究科

A03 12:20~12:40

自立 GaN 基板上に成長した Eu 添加 GaN の発光特性評価

若松龍太, 李東建, 小泉淳, 寺井慶和, 藤原康文

大阪大学大学院工学研究科

A04 12:40~13:00

酸化モリブデン薄膜の分子線エピタキシャル成長と特性評価

藤本龍吾, 和田涼太, 小池一步, 佐々誠彦, 矢野満明

大阪工業大学ナノ材料マイクロデバイス研究センター

休憩 13:00~13:50

B01 13:50~14:10

大気圧非平衡窒素/酸素プラズマを用いた ZnO 薄膜の低温成長

野瀬幸則<sup>\*1</sup>, 吉村武<sup>\*1</sup>, 芦田淳<sup>\*1</sup>, 上原剛<sup>\*2</sup>, 藤村紀文<sup>\*1</sup>

(\*1) 大阪府立大学大学院工学研究科, (\*2) 積水インテグレートリサーチ

B02 14:10~14:30

電着法による酸化亜鉛のエピタキシャル成長～各種基板上での検討～

妻神光輝, 宇野和行, 田内康大, 石井良典, 田中一郎

和歌山大学システム工学部

B03 14:30~14:50

コランダム型酸化物薄膜のエンジニアリング

金子健太郎, 藤田静雄

京都大学大学院工学研究科

B04 14:50~15:10

InAs 薄膜からの THz 波放射強度増加のための反射層の検討

西坂和一<sup>\*1</sup>, 高山和久<sup>\*2</sup>, 前元利彦<sup>\*1</sup>, 佐々誠彦<sup>\*1</sup>, 井上正崇<sup>\*1</sup>, 斗内政吉<sup>\*2</sup>

(\*1) 大阪工業大学ナノ材料マイクロデバイス研究センター, (\*2) 大阪大学レーザーエネルギー学研究中心

休憩 15:10~15:20

C01 15:20~15:40

医療・生体イメージング光源に向けた 1 ミクロン帯広帯域発光 InAs 量子ドットの作製

日野雄司<sup>\*1</sup>, 尾崎信彦<sup>\*1</sup>, 大河内俊介<sup>\*2</sup>, 池田直樹<sup>\*3</sup>, 杉本喜正<sup>\*3</sup>

(\*1) 和歌山大学システム工学部, (\*2) NEC, (\*3) 物質材料機構

C02 15:40~16:00

量子ドット光アンプの利得スペクトル測定

諏訪雅也, 喜多隆

神戸大学大学院工学研究科

C03 16:00~16:20

MgCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>-TiO<sub>2</sub> 系セラミックスガスセンサ素子の添加物効果

寺田二郎, 平原陽介, 杉本祐樹, 大松 繁, 佐々誠彦, 矢野満明

大阪工業大学ナノ材料マイクロデバイス研究センター

C04 16:20~16:40

ベンゾジチオフェンダイマー薄膜を用いた電界効果トランジスタにおけるペンタセン結晶性制御層の検討

阪井智哉, 松本雄太郎, 大須賀秀次, 宇野和行, 田中一郎

和歌山大学システム工学部